

Lundi 30 Mai 2016

8h45-09h00	Bienvenue aux JNMO 2016
9h00-09h35	Anne GHIS, CEA LETI Nanomembranes pour MEMS.
9h35-10h10	Bernhard URBASZEK, LPCNO Les Dichalcogénures de Métaux de Transition : Nouveaux semi-conducteurs bidimensionnels pour l'optoélectronique.
10h10-10h40	Pause café
10h40-11h15	Xavier JEHL, INAC CEA Nanoelectronique sur silicium : du transistor au bit quantique.
11h15-11h50	Nicolas CAVASSILAS, IM2NP Modélisation du transport électronique quantique pour le Nano-PV et les nano-transistors.
11h50-12h25	Romain Bachelet, INL Oxydes fonctionnels intégrés sur Si pour des applications en énergie et photonique.
12h25-12h45	Jean-Baptiste DOUCET, LAAS (RENATECH) Transfert de nanostructures dans la silice par nanoimpression avec résines "maison".

12h45-14h30

DEJEUNER

14h30-15h05	Guilhem LARRIEU, LAAS Transistors 3D à nanofils pour les applications nanoélectroniques.
15h05-15h40	Bruno DAUDIN, Institut Néel Grandeur et limitations des LEDs visibles à base d'hétérostructures bidimensionnelles de nitrures d'éléments III : les nanofils peuvent-ils permettre d'aller plus loin?
15h40-16h15	Emmanuel Lhuillier, INSP Optoélectronique des nanocristaux colloïdaux.
16h15-16h45	Pause café
16h45-17h20	Guillaume BAFFOU, INSTITUT FRESNEL Propriétés photothermiques de nanoparticules d'or. Applications récentes.
17h20-17h40	Aurélié LECESTRE, LAAS (RENATECH) Gravure de nanofils GaAs sur substrat Si(100) pour l'intégration de nano-transistors 3D.
17h40-19h30	POSTER 1
20h00	DINER

Mardi 31 Mai 2016

8h30-09h05	Antoine MOREAU, INSTITUT PASCAL Méta-surfaces et plasmonique.
9h05-09h40	Damien QUERLIOZ, IEF Nouveaux composants mémoire: vers la mémoire intelligente.
9h40-10h15	Jean-Yves DUPUY, III-V Lab Amplificateurs distribués en TBH InP pour télécommunications optiques à 100 Gbit/s et au-delà.
10h15-10h45	Pause café
10h45-11h20	Farid MEDJDOUB, IEMN Composants GaN pour les applications allant de la conversion DC/DC de forte puissance jusqu'au domaine THz
11h20-11h55	Guillaume DUCOURNAU, IEMN Intérêt de la photonique pour le développement des systèmes de communication sans fil en gamme THz.
11h55-12h15	Mickael MARTIN, LTM (RENATECH) Croissance de III-V/Si par MOCVD 300 mm.

12h15-14h00

DEJEUNER

14h00-14h35	Pascal CHEVALIER, STMicroelectronics Technologies BiCMOS SiGe pour applications millimétriques et Térahertz.
14h35-15h10	Alain MAESTRINI, Observatoire de Paris-LERMA Diodes Schottky pour l'exploration de l'univers à haute résolution spectrale.
15h10-15h30	Jean-René COUDEVYILLE, IEF (RENATECH) Dispositifs THz.
15h30-17h30	Pause café & POSTER 2
17h30-19h30	Démonstration lien THz Table ronde Thème : Télécommunication THz.
20h00-24h00	SOIRÉE DE GALA

Mercredi 1 Juin 2016

8h30-09h05	Han SIGG, Paul Scherrer Institut (PSI) - Suisse Progress and Challenges towards efficient group IV based direct band gap lasing.
9h05-09h40	Jean-François CARPENTIER, STMicroelectronics Traitement du signal tout optique sur puce et entre puces.
9h40-10h15	Ségolène OLIVIER, CEA LETI Lasers hybrides III-V sur Silicium pour les prochaines générations de réseaux télécoms et datacoms.
10h15-10h45	Pause café
10h45-11h20	Delphine MARRIS-MORINI, IEF La photonique silicium pour les communications optiques haut débits.
11h20-11h40	Gwenn ULLIAC, Femto-ST (RENATECH) Usinage du matériau niobate de lithium et Applications en optique intégrée.
11h40-13h15	Conclusion des JNMO 2016 & DEJEUNER

13h15

Départ navette vers gare SNCF St. Raphaël

PROGRAMME JNMO 2016